Кремниевый фотодетекторный чип 3 мм — техническое описание

P/N : WS9Z-01C

Применение

Si PIN фотодиодные чипы

Структура

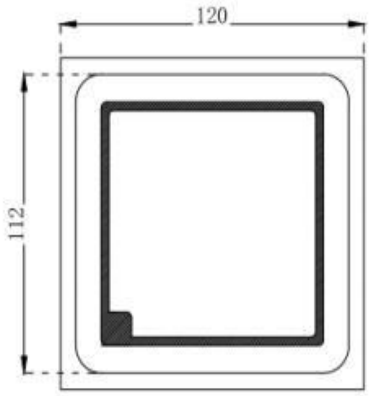
Планарная структура: PIN-диод; электроды: верхняя сторона (катод) — Al, задняя сторона (анод) — сплав Au

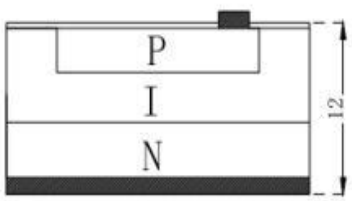
ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	112 мил × 112 мил (±0.5 мил)			мил
Ширина чипа	120 мил × 120 мил (±1.5 мил)			мил
Длина чипа	120 мил × 120 мил (±1.5 мил)			мил
Высота чипа	12 мил ±(1.0 мил)			мил
Контактная площадка катода	6 мил (±0.2 мил)			мил
Контактная площадка анода	6 мил (±0.2 мил)			мил

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	VF	IF=10mA, H=0	0.5		1.3	В
Обратное напряжение	VBR	IR=100μA, H=0	35			В
Обратный темновой ток	ID	VR=10V, H=0			10	нА
Рабочий диапазон длин волн	λp			525		нм
Емкость	CJ	VR=5V, F=1 MHz		16		пФ





Ед.: мил

WING CHIP 武汉万赢半导体科技有限公司
WUHAN WING CHIP SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY Co.,LTD.

Дистрибьютор в РФ ООО «Промэнерголаб»
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 1, Тел.: +7 495 677-92-08, 8 (800) 234-12-08, info@czl.ru, www.czl.ru